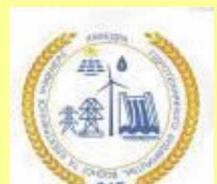


**ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

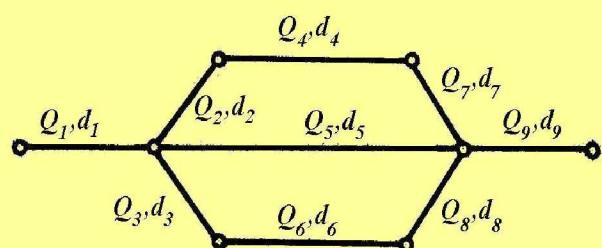


**«ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВництво:
МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЕ»**

Збірка наукових праць



$$Q = S\omega = SC\sqrt{RJ}$$



Херсон, 2023

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Факультет архітектури та будівництва
Кафедра гідротехнічного будівництва, водної та електричної інженерії

**ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО:
МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ**

Збірка наукових праць

ВИПУСК VI

Херсон, 2023

Висновки. Сучасний стан тривало зрошуваних ґрунтів Кримського Присивашня характеризується зміною промивного режиму зрошення на непромивний за рахунок зниження зрошувальної норми. Це з часом змінює ефективність горизонтального дренажу з високої на задовільну, хоч використання зрошуваних земель на всіх варіантах дослідження залишається ефективним.

УДК 546.64.73

Заводянний В.В.

Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

УТОЧНЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ СПОЛУКИ K_3TiOF_5

Вступ. Сегнетоелектричні матеріали використовують в конденсаторах змінної ємності. Діелектрична проникність сегнетоелектричних матеріалів не лише налаштовується але і дуже велика. Тому сегнетоелектричні конденсатори набагато менші за розмірами та мають більшу електроємність у порівнянні з діелектричними конденсаторами. Порівнянно недавно було синтезовано ряд матеріалів, що мають сегнетоелектричні властивості, до яких належить і K_3TiOF_5 [1]. Вихідні матеріали KF (Ventron, чистота > 99,9%), оксиди TiO_2 , Nb_2O_5 , Ta_2O_5 , WO_3 (Cerac, 99,95%) попередньо висушенні у вакуумі при температурі 473К протягом 20 годин. Оксифториди $TiOF_2$, NbO_2F , TaO_2F отримують дією 40% розчину плавикової кислоти на відповідні оксиди в тефлоновій ванні, після повного випаровування розчину на пісочній ванні при 373К. Залишкові тверді продукти дегазуються у вакуумі при температурі 473К. Близько 18г суміші зважують в стехіометричних пропорціях, розтирають в агатовій ступці в сушильній шафі, потім розміщують в біконічний платиновий 10% родієвий тиглі. Сполучу отримують в наступній реакції $3KF + TiOF_2 \rightarrow K_3TiOF_5$. Після дегазації в вакуумі протягом 20 годин при 473К а потім герметизації в атмосфері сухого кисню тигель обпалюють при температурі реакції протягом 24 годин а потім при температурі плавлення +50К [1].

Основна частина. Об'єктом дослідження є кристалічна структура сполучки K_3TiOF_5 .

В базі даних PDF-2 за 2009 р. міститься проіндексований дифракційний спектр, отриманих для сполучки K_3TiOF_5 . Кристалічна структура даного спектру невідома.

Мета роботи – запропонувати структурну модель для дифракційного спектру сполучки K_3TiOF_5 під номером 00-023-0506 в базі даних PDF-2 за 2009 р.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

1. Визначити періоди решітки та сингонію, в якій кристалізується досліджувана сполучка.

2. Обрати просторову групу симетрії та запропонувати структурну модель для даного спектру сполуки.

3. Провести уточнення мікроструктурних параметрів для обраної моделі методом Рітвельда.

Сольватермічний синтез K_3TiOF_5 проводився в автоклаві із нержавіючої сталі з тефлоновою футеровкою при зниженному тиску. Всі реагенти (KOH , $KF \cdot 2H_2O$, TiO_2 , Ti , NH_4HF_2 , H_2O_2) і метанол були аналітично чистими і використовувались без додаткової очистки (придбаними Shanghai Chemical Reagent Company). Суміш у стехіометричному співвідношенні поміщають в мілілітровий автоклав із нержавіючої сталі з тефлоновим покриттям, котрий потім заповнюють метанолом до 80-кратного загального об'єму. Автоклав швидко закривали і нагрівали при температурі $200^{\circ}C$ протягом 24 або 36 годин та охолоджували природним шляхом до кімнатної температури. Осадки збирали і промивали етанолом, дистильованою водою відповідно та сушили у вакуумі при $60^{\circ}C$ протягом 2 годин [3].

Від отриманого зразка знімалась дифрактограма методом порошку з геометрією зйомки Брег-Брентано. Дифракційний спектр відповідає K_3TiOF_5 під номером 00-023-0506 в базі даних PDF-2 [2, 3] індексується в тетрагональній сингонії, з періодами решітки $a=6,102^{\circ}A$, $c=8,655^{\circ}A$.

Результати аналізу літератури свідчать про те, що кристалічна структура досліджуваної сполуки невідома. Своїми електричними властивостями може бути використана як сегнетоелектрик.

Методи дослідження. Дифракційні спектри сполук для дослідження генерували за допомогою програми HighScorePlus 3.0 та приєднаної до неї бази даних PDF-2 за 2009 р. у форматі UDF.

Аналіз запропонованої структурної моделі даного спектру проводили за допомогою програми HighScorePlus 3.0 методом Рітвельда.

Дифракційний спектр сполуки K_3TiOF_5 індексується в тетрагональній сингонії з періодами решітки $a=6.086$ Å; $b=6.086$ Å; $c=8.675$ Å. Можлива просторова група симетрії $I41$ (80).

Правильна система точок та уточнені їх координати для даного спектру представлені в табл. 1.

Таблиця 1
Мікроструктурні параметри K_3TiOF_5 для спектру 00-023-0506 в базі даних PDF-2 за 2009 р.

Atom	Wyck.	s.o.f.	x	y	z	U_{iso}^a
K1	8b	0.500000	0.252(9)	0.588(4)	0.2(4)	0(1)
K2	8b	1.000000	0.233(5)	0.233(5)	0.4(4)	5.8(4)
F1	8b	1.000000	-0.900(8)	0.393(4)	0.1(4)	10(1)
O1	4a	1.000000	0.000000	0.000000	0.1(4)	0(1)
F2	8b	1.000000	0.749(7)	0.262(7)	0.8(4)	0(1)
F3	8b	0.500000	0.47(1)	0.696(9)	-0.1(4)	0(2)
Ti1	8b	0.500000	0.247(5)	0.803(4)	0.1(4)	0(1)

Примітка: Wyck. – правильна система точок; s.o.f. – коефіцієнт заповнення позицій атомами; x, y, z – координати атомів в долях періодів решітки ($x=X/a$; $y=Y/b$; $z=Z/c$); U_{iso}^a – температурний фактор

Фактор розбіжності $R=7.311\%$.

На рис. 1. представлена дифрактограма згенерована та розрахована за структурною моделлю для сполуки K_3TiOF_5 .

На рис. 2 представлено зображення запропонованої моделі кристалічної структури досліджуваної сполуки.

Просторова група симетрії $I4_1$ (80) має поворотну вісь симетрії 2-го порядку, паралельну 001, гвинтову вісь 4-го порядку з трансляцією $1/3$ с паралельну 001.

Також, часткове заповнення правильних систем точок в досліджуваній структурі, може вказувати на те, що стехіометричний склад сполуки може бути дещо змінений. Отже структура сполуки потребує подальшого дослідження.

Даний матеріал є сегнетоелектрик. Діелектрична проникність матеріалів дуже велика. Тому даний матеріал може бути використаний в конденсаторах, які значно менші за розмірами за діелектричні. Порівняно недавно було синтезовано ряд матеріалів, що мають сегнетоелектричні властивості, до яких належить і K_3TiOF_5 . Вивчення кристалічної структури матеріалу дозволяє більш детально оцінити його сегнетоелектричні властивості, та проводити теоретичні розрахунки цих властивостей.

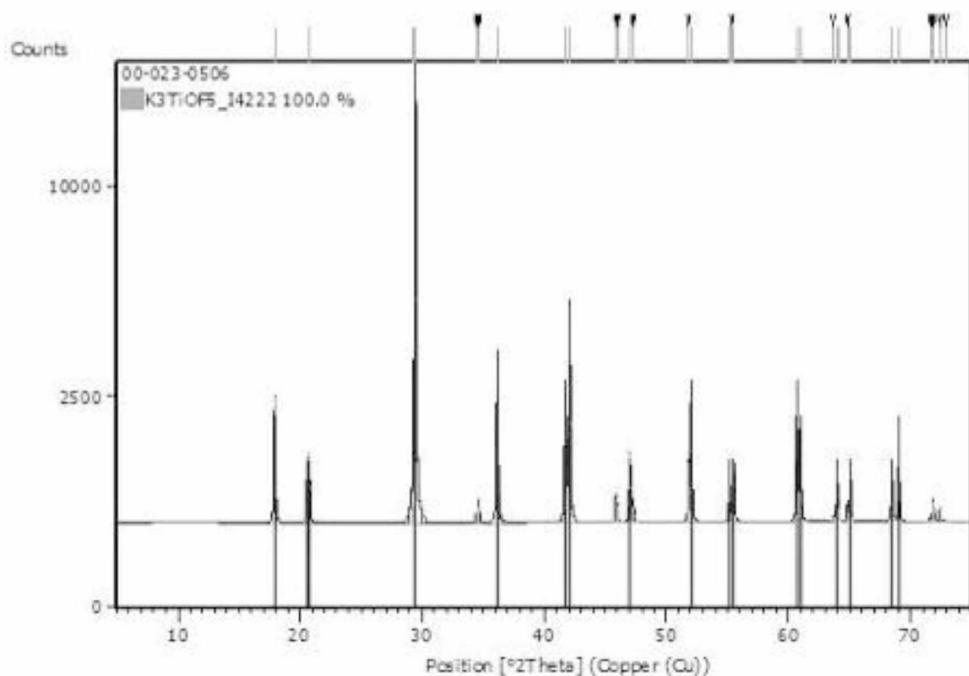


Рис. 1 Результатуюча дифрактограма сполуки K_3TiOF_5 згенерована та розрахована за структурною моделлю

Висновки. 1. За допомогою програми TREOR проведено Дифракційний спектр сполуки K_3TiOF_5 індексується в тетрагональній сингонії з періодами решітки $a=6.086\text{ \AA}$; $b=6.086\text{ \AA}$; $c=8.675\text{ \AA}$.

Дифракційний спектр β -фази (сполука 00-049-0903) індексується в орторомбічній сингонії з періодами решітки $a=8.668(7)$ Å; $b=8.677(8)$ Å; $c=8.685(7)$ Å.

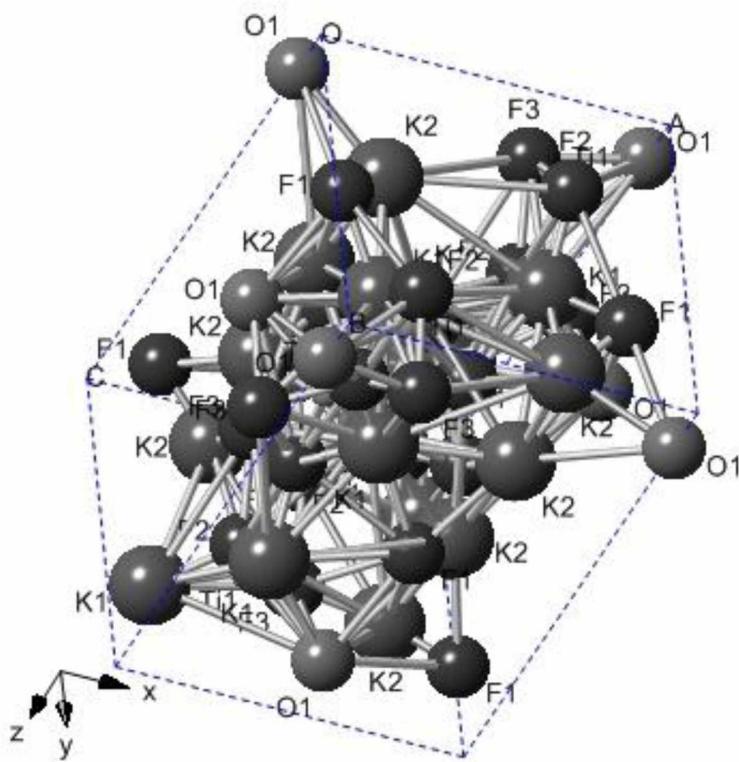


Рис. 2 Кристалічна структура сполуки K_3TiOF_5 . для досліджуваного дифракційного спектру

2. Можлива просторова група симетрії $I41$ (80). та запропоновано для розрахунку структурну модель.

3. За допомогою програми HighScorePlus 3.0 методом Рітвельда уточнено параметри структурної моделі досліджуваної сполуки. Мікроструктурні параметри приведені у табл. 1.

Список використаної літератури:

1. MA Fouad, JP Chaminade, J Ravez, and A Sadel. Ferroelastic domain study in crystals with formula K_3TiOF_5 , $K_3MO_2F_4$ and $K_3M'O_3F_3$ ($M= Nb, Ta$; $M'= Mo, W$). In Advanced Materials Research. 1994. V. 1, p. 469-478. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1-2.469>

2. PDF-2 data bases for 2009 <https://www.icdd.com/pdf-2/>

3. Jie Sheng, Kaibin Tang, Wei Cheng, Junli Wang, Yanxiang Nie, and Qing Yang. Controllable solvothermal synthesis and photocatalytic properties of complex (oxy)uorides K_2TiOF_4 , K_3TiOF_5 , $K_7Ti_4O_4F_7$ and K_2TiF_6 . Journal of Hazardous Materials. 2009. V. 171. №13. P279-287. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.141>